

## SPROSTOWANIA

**Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1922 z dnia 10 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania**

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319 z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Strona 129, pozycja 3B001.f., w pkt 3 i 4 zmienia się wyrównanie tekstu:

- zamiast:* „3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spełniający wszystkie poniższe kryteria:
- a. posiadający odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów, jonów lub wiązkę „laserową”; oraz
  - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
    1. apertura płamki dla szerokości piku w połowie jego wysokości poniżej 65 nm i umiejscowienie obrazu poniżej 17 nm (średnia + 3 sigma); lub
    2. nieużywane;
    3. błąd nakładania drugiej warstwy mniejszy niż 23 nm (średnia + 3 sigma) na maskę;
    4. Sprzęt zaprojektowany do wytwarzania przyrządów wykorzystujący metody bezpośredniego nadruku i spełniający wszystkie poniższe kryteria:
      - a. wykorzystujący odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów; oraz
      - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
        1. minimalny rozmiar wiązki równy lub mniejszy niż 15 nm; lub
        2. błąd nakładania warstwy mniejszy niż 27 nm (średnia + 3 sigma);”;
- powinno być:* „3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spełniający wszystkie poniższe kryteria:
- a. posiadający odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów, jonów lub wiązkę „laserową”; oraz
  - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
    1. apertura płamki dla szerokości piku w połowie jego wysokości poniżej 65 nm i umiejscowienie obrazu poniżej 17 nm (średnia + 3 sigma); lub
    2. nieużywane;
    3. błąd nakładania drugiej warstwy mniejszy niż 23 nm (średnia + 3 sigma) na maskę;
    4. Sprzęt zaprojektowany do wytwarzania przyrządów wykorzystujący metody bezpośredniego nadruku i spełniający wszystkie poniższe kryteria:
      - a. wykorzystujący odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów; oraz
      - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
        1. minimalny rozmiar wiązki równy lub mniejszy niż 15 nm; lub
        2. błąd nakładania warstwy mniejszy niż 27 nm (średnia + 3 sigma);”;
-